

2SA509

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

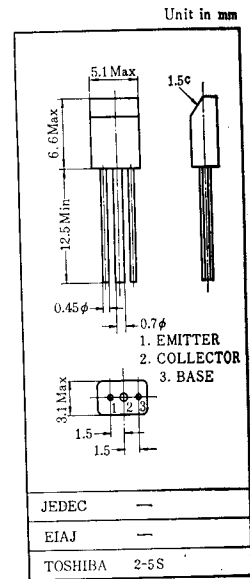
○低周波電力増幅用

○ Audio Power Amplifier Applications.

- B級プッシュプルで1Wの出力が得られます；
- 2SC509とコンプリメンタリになります；
- 1 Watt Amplifier Applications
- Complementary to 2SC509

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-35	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	-30	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-500	mA
エミッタ電流	I _E	500	mA
コレクタ損失	P _C	600	mW
接合温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C



アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =-20V, I _E =0	—	—	-100	nA
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =-5V, I _C =0	—	—	-100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C =-10mA, I _B =0	-30	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E =-0.1mA, I _C =0	-5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h _{FE}	V _{CE} =-2V, I _C =-50mA	70	100	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =-500mA, I _B =-20mA	—	-0.3	-0.8	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =-10V, I _E =10mA	—	140	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz	—	22	30	pF

Note ; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE(1)}, the 2SA509 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA509—O	70	140
2SA509—Y	120	240

P_C-T_a

